

# BC817

Rev.F Apr.-2017

## 描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

## 特征 / Features

$I_C$  大, 与 BC807 互补。

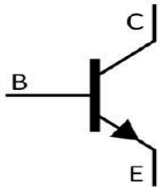
High  $I_C$ , complementary pair with BC807.

## 用途 / Applications

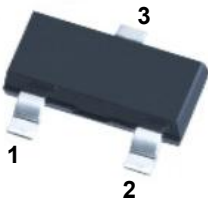
用于一般功率放大及开关电路。

Purpose: General power amplifier and switching application.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base

PIN 2 : Emitter

PIN 3 : Collector

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	16	25	40
$h_{FE}$ Range	100~250	160~400	250~600
Marking	H6A	H6B	H6C

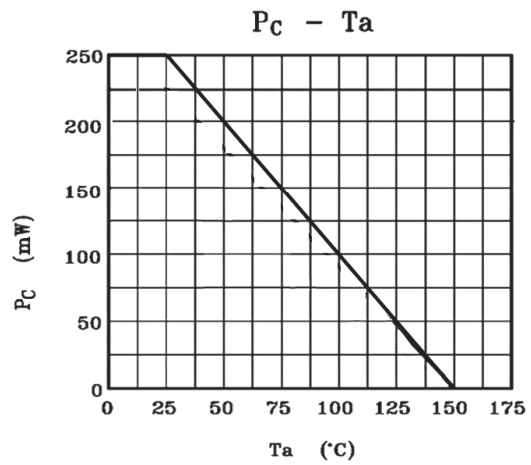
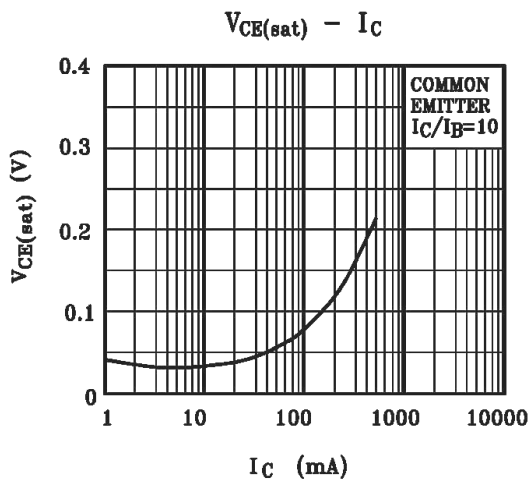
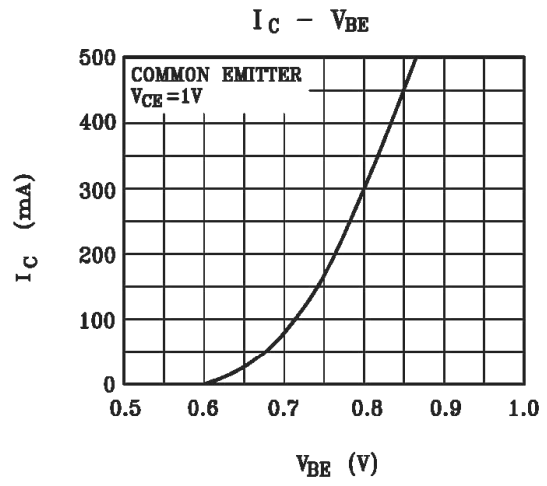
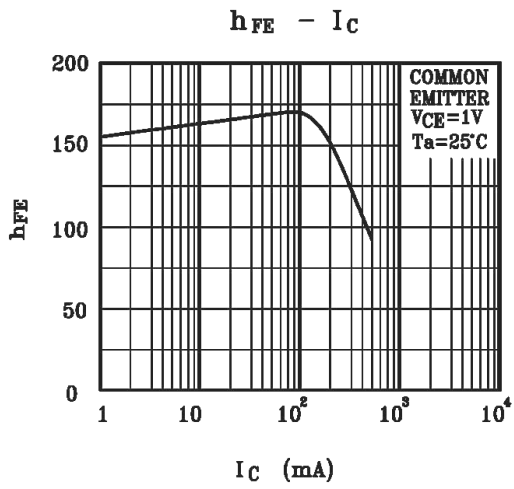
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	50	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	45	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	500	mA
Collector Current - peak collector current	$I_{CM}$	1.0	A
Collector Power Dissipation	$P_C$	250	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	50			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=10mA$ $I_B=0$	45			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=100mA$	100		600	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=500mA$	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$			0.7	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=500mA$			1.2	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	100			MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$ $I_E=0$		5.0		pF

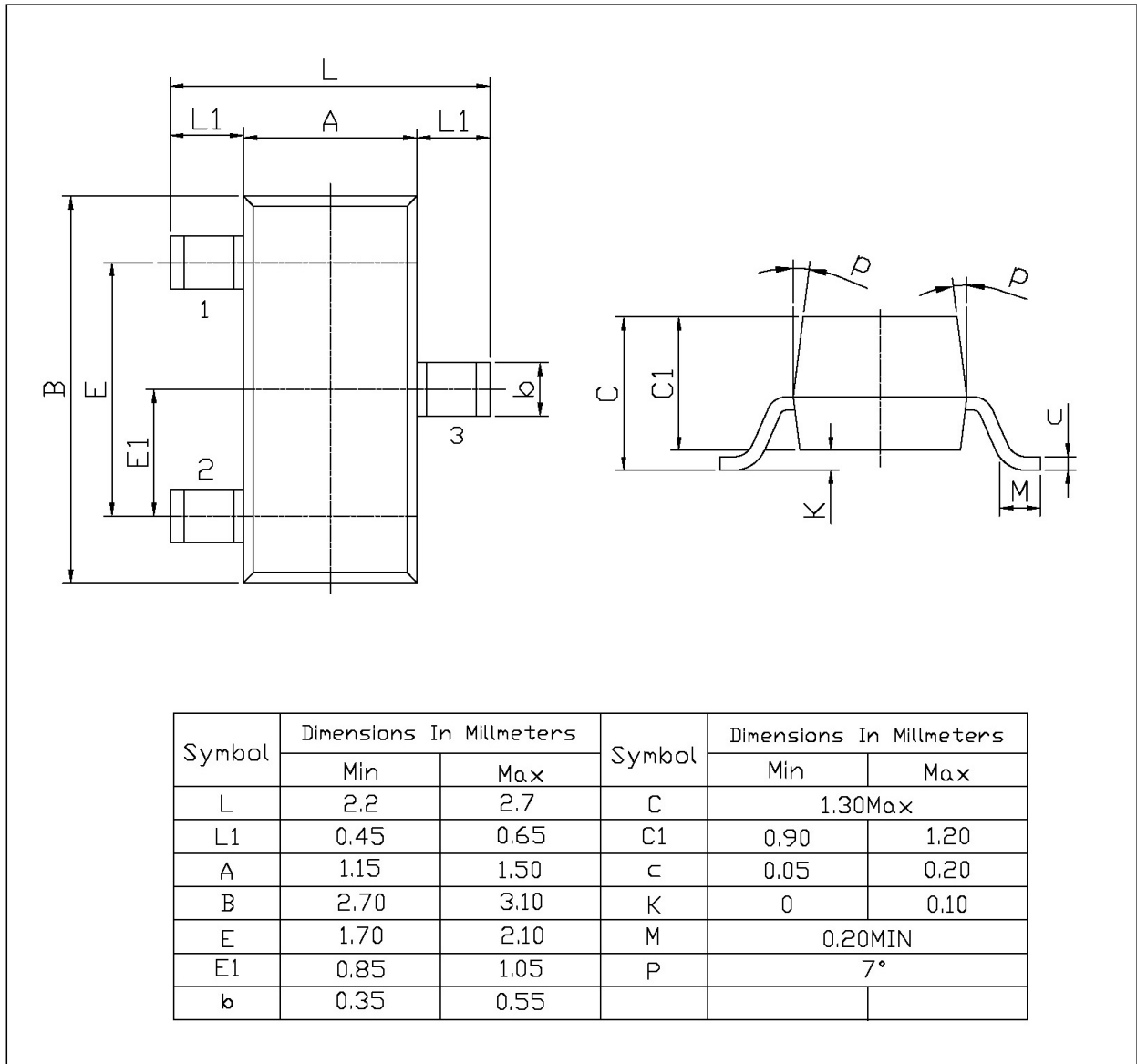
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



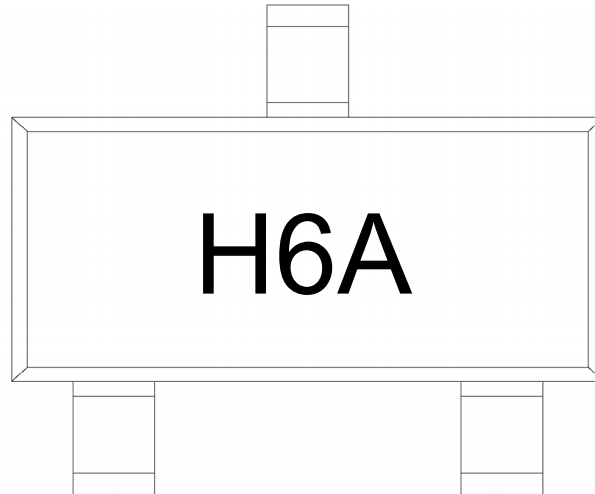
外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

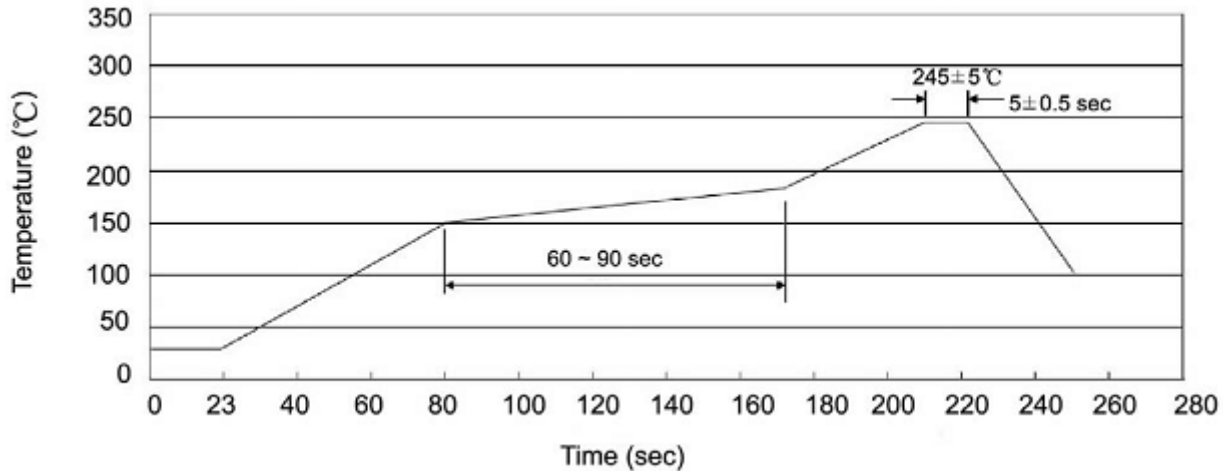
H： 为公司代码

6A： 为型号代码

Note:

H: Company Code

6A: Product Type Code

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**


说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)  
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC4731T-AY](#)  
[2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#)  
[MCH4021-TL-E](#) [MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [SZT1010T1G](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#)  
[UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#)